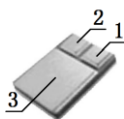
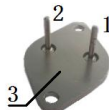
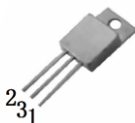


CS150 型 N 沟道场效应晶体管

参数符号		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
极 限 值	P_D	$T_C=25^{\circ}\text{C}$			150	W
	线性降低系数		1.2			W/ $^{\circ}\text{C}$
	I_D	($V_{GS}=10\text{V}, T_C=25^{\circ}\text{C}$)			38	A
	I_D	($V_{GS}=10\text{V}, T_C=100^{\circ}\text{C}$)			24	A
	I_{DM}				152	A
	V_{GS}				± 20	V
	T_{jm}				+150	$^{\circ}\text{C}$
	T_{stg}		-55		+150	$^{\circ}\text{C}$
热 特 性	R_{thJC}				0.83	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
电 特 性	BV_{DSS}	$V_{GS}=0\text{V}, I_D=1.0\text{mA}$	100			V
	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=24\text{A}$			0.055	Ω
		$V_{GS}=10\text{V}, I_D=38\text{A}$			0.065	Ω
	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=0.25\text{mA}$	2.0		4.0	V
	g_{fs}	$V_{DS}=25\text{V}, I_{DS}=24\text{A}$	9.0			S
	I_{DSS}	$V_{DS}=80\text{V}, V_{GS}=0\text{V}$			25	μA
		$V_{DS}=80\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, T_J=125^{\circ}\text{C}$			250	
	I_{GSS}	$V_{GS}=20\text{V}$			100	nA
$V_{GS}=-20\text{V}$				-100		
外 引 线 说 明	 SMD-2.0  B2-01C(F2)  TO-257 1. S 源极 2. G 栅极 3. D 漏极					
替代型号: IRF150						